Docket No. 209128US0

#### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Tetsuya NAKASHIMA, et al.

GAU:

SERIAL NO: NEW APPLICATION

**EXAMINER:** 

FILED:

**HEREWITH** 

FOR:

GLASS FOR SUBSTRATE AND GLASS SUBSTRATE

#### REQUEST FOR PRIORITY

ASSISTANT COMMISSIONER FOR PATENTS WASHINGTON, D.C. 20231

#### SIR:

**COUNTRY** 

**JAPAN** 

- □ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number, filed, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- □ Full benefit of the filing date of U.S. Provisional Application Serial Number, filed, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e).
- Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:

**APPLICATION NUMBER** 

2000-164556

JAPA	N	2000-164557	June 1, 2000
Certifie	ed copies of the corresponding	Convention Application(s)	
	are submitted herewith		
	will be submitted prior to pay	ment of the Final Fee	
	were filed in prior application	Serial No. filed	
		ional Bureau in PCT Application Number by the International Bureau in a timely m y the attached PCT/IB/304.	
	(A) Application Serial No.(s)	were filed in prior application Serial No.	. filed ; and
	(B) Application Serial No.(s)		
	□ are submitted herewith		
	□ will be submitted prior	to payment of the Final Fee	•

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.

Norman F. Oblon

Registration No.

24,618

MONTH/DAY/YEAR

June 1, 2000

C. Irvin McClelland Registration Number 21,124



22850

Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 10/98)

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE LA SI E SI AB - 3 08 //L

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年 6月 1日

出願番号

Application Number:

特願2000-164556

出 願 人
Applicant(s):

旭硝子株式会社

2001年 4月27日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】

特許願

【整理番号】

20000390

【提出日】

平成12年 6月 1日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

C03C 3/085

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭硝子株

式会社内

【氏名】

中島 哲也

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地 旭硝子株

式会社内

【氏名】

中尾 泰昌

【特許出願人】

【識別番号】 000000044

【氏名又は名称】 旭硝子株式会社

【代表者】

石津 進也

【電話番号】

03-3218-5645

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 042619

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

# 【書類名】明細書

【発明の名称】基板用ガラスおよびガラス基板

# 【特許請求の範囲】

# 【請求項1】

質量百分率表示で実質的に、

SiO $_2$	40~59%、
A $^{1}_{2}$ O $_{3}$	$5\sim20\%$
$B_2O_3$	0~8%,
MgO	$0 \sim 1 0 \%$
СаО	0~12%、
SrO	$2 \sim 17\%$
ВаО	$0 \sim 2 \%$
ZnO	$0 \sim 4 \%$
Li <sub>2</sub> O	$0 \sim 2 \%$
Na <sub>2</sub> O	$0 \sim 1 0 \%$
к <sub>2</sub> о	$0 \sim 1 2 \%$
T i $O_2$	$0 \sim 1 0 \%$
ZrO2	$0 \sim 5 \%$

からなり、 $MgO+CaO+SrO+BaO \ge 15%$ かつ $Al_2O_3+TiO_2 \ge 11%$ である基板用ガラス。

# 【請求項2】

 $BaO+Li_2O+Na_2O+K_2O \le 14%$ である請求項1に記載の基板用ガラス。

# 【請求項3】

 $50\sim350$  Cにおける平均線膨張係数が $70\times10^{-7}$ / C以上である請求項 1 または2 に記載の基板用ガラス。

# 【請求項4】

ガラス転移点が600℃以上である請求項1、2または3に記載の基板用ガラス。

#### 【請求項5】

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

#### 【発明の属する技術分野】

本発明は、磁気ディスク、光ディスク等の情報記録媒体の基板、PDP(プラズマディスプレイパネル)、FED(フィールドエミッションディスプレイ)等のフラットディスプレイの基板、等に用いられる基板用ガラスおよびガラス基板に関する。

[0002]

# 【従来の技術】

情報記録媒体基板、フラットディスプレイパネル基板、等に用いられる基板用 ガラスとして、ソーダライムシリカガラスが広く用いられている。

[0003]

#### 【発明が解決しようとする課題】

しかし、ソーダライムシリカガラスからなる基板は、いわゆる白ヤケ現象によりその在庫中に表面性状が著しく変化するおそれがあった。特に磁気ディスク基板の場合には、前記基板上に形成される下地膜、磁性膜、保護膜等の膜がはがれやすくなる。

[0004]

ソーダライムシリカガラスは化学強化処理によって白ヤケ現象が起りにくくなる。しかし化学強化処理には、工程が増加する、化学強化処理後の基板表面によごれが付着しやすい、等の問題がある。

本発明は、化学強化処理等の付加処理を行わなくとも耐候性に優れ、白ヤケ現象が起りにくい基板用ガラスの提供を目的とする。

[0005]

# 【課題を解決するための手段】

本発明は、質量百分率表示で実質的に、

SiO <sub>2</sub>	40~59%、
Al $_2$ O $_3$	$5\sim20\%$
$B_2O_3$	0~8%、
МgО	$0 \sim 1 0 \%$
СаО	$0 \sim 1 2 \%$
SrO	$2 \sim 17\%$
ВаО	$0 \sim 2 \%$
ZnO	$0 \sim 4 \%$
L i <sub>2</sub> O	$0 \sim 2 \%$
Na <sub>2</sub> O	$0 \sim 1 0 \%$ .
K <sub>2</sub> O	$0 \sim 1 2 \%$
T i $O_2$	$0 \sim 1 0 \%$
$zro_2$	$0 \sim 5 \%$

からなり、 $MgO+CaO+SrO+BaO \ge 15%$ かつ $A1_2O_3+TiO_2 \ge 11%$ である基板用ガラスを提供する。

また、前記基板用ガラスからなるガラス基板であって、120  $\mathbb C$ 、2 気圧の水蒸気雰囲気に20 時間保持した該ガラス基板表面に存在する大きさが10  $\mu$  m以上の付着物の数が1 個/  $\mathbb C$   $\mathbb C$ 

[0006]

#### 【発明の実施の形態】

本発明の基板用ガラスは、磁気ディスク、光ディスク等の情報記録媒体の基板、PDP、FED等のフラットディスプレイの基板等に用いられる。

本発明の基板用ガラスの $50\sim350$  における平均線膨張係数は、ソーダライムシリカガラスと同程度またはそれ以上、すなわち $70\times10^{-7}/\mathbb{C}$ 以上であることが好ましい。より好ましくは $75\times10^{-7}/\mathbb{C}$ 以上である。以下、 $50\sim350$  における平均線膨張係数を単に膨張係数という。

#### [0007]

上記の膨張係数が好ましい理由は、情報記録媒体基板に対しては、基板に取り付けるハブの金属の膨張係数(典型的には100×10<sup>-7</sup>/℃以上)により近い膨張係数、少なくとも従来使用されているソーダライムシリカガラスの膨張係数以上、が好ましいからである。フラットディスプレイパネル基板に対しては、シール等に従来使用されているガラスフリット等の従来の無機材料粉末の膨張係数がソーダライムシリカガラス基板の膨張係数に整合しており、前記従来の無機材料粉末の膨張係数と整合させやすくするためである。

#### [0008]

本発明の基板用ガラスのガラス転移点は600℃以上であることが好ましい。 より好ましくは610℃以上、最も好ましくは620℃以上である。

上記のガラス転移点が好ましい理由は、情報記録媒体用基板に対しては、記憶 密度の増大が容易になるからである。

すなわち、記憶密度増大のためには、磁気記録層である磁性層の保磁力を増加させることが有効であり、そのためには磁性層形成に際して行われる熱処理をより高い温度で行う必要がある。情報記録媒体用基板に用いられるガラスのガラス転移点が600℃未満では所望の温度で前記熱処理を行えないおそれがある。

#### [0009]

また、フラットパネルディスプレイ基板に対しては、ディスプレイ製造時における熱処理によってガラス基板に生じる変形または収縮といった寸法変化を抑制 しやすいからである。

すなわち、寸法が著しく変化すると前面基板および背面基板の位置合わせが困難となるが、ディスプレイの高精細化により、近年では寸法変化の許容値がますます小さくなってきている。フラットパネルディスプレイ基板に用いられるガラスのガラス転移点が600℃未満では、前記熱処理によってガラス基板に生じる変形または収縮等による寸法変化が大きくなり、前記許容値を満たせなくなるおそれがある。

# [0010]

本発明の基板用ガラスは、その粘度が $10^4$ Pとなる温度 $T_A$ と液相温度 $T_I$ と

の差 $\Delta$ T(= $T_L$ - $T_4$ )が50C以下、すなわち $\Delta$ T  $\leq$  50Cであることが好ましい。 $\Delta$ T が50C超では成形が困難になるおそれがある。より好ましくは30C以下、特に好ましくは0C以下である。

# [0011]

次に、本発明の基板用ガラスの組成について、質量百分率表示で以下に説明する。

 $SiO_2$ はガラスの骨格を形成する必須成分である。40%未満では、ガラスが不安定になる、または化学的耐久性、特に耐酸性が低下する。好ましくは41%以上、より好ましくは45%以上、特に好ましくは49%以上、最も好ましくは50%以上である。59%超では、膨張係数が小さくなりすぎる。好ましくは58.5%以下である。

#### [0012]

 $A1_2O_3$ はガラスの耐候性を高くする効果またはガラス転移点を高くする効果を有し、必須である。5%未満では前記効果が小さい。好ましくは6%以上である。20%超では溶融ガラスの粘度が高くなりすぎ、または液相温度が高くなりすぎ、成形が困難になる。好ましくは19%以下、より好ましくは17%以下、特に好ましくは15%以下である。

#### [0013]

 $B_2O_3$ は必須ではないが、ガラスの耐候性を高くする効果を有し、8%まで含有してもよい。8%超では膨張係数が小さくなりすぎるおそれがある。好ましくは7%以下である。 $B_2O_3$ を含有する場合、1%以上含有することが好ましい。

#### [0014]

MgOは、必須ではないが、溶融ガラスの粘度を低下させガラスを溶融しやすくする効果を有し、10%まで含有してもよい。10%超ではガラスが不安定になるおそれがある。好ましくは9%以下である。MgOを含有する場合、1%以上含有することが好ましい。

# [0015]

CaOは、必須ではないが、溶融ガラスの粘度を低下させガラスを溶融しやすくする効果を有し、12%まで含有してもよい。12%超ではガラスが不安定に

なるおそれがある。好ましくは11%以下である。CaOを含有する場合、1%以上含有することが好ましい。なお、耐候性をより向上させたい場合、または液相温度をより低下させたい場合にはCaOを実質的に含有しないことが好ましい

#### [0016]

SrOは膨張係数を大きくし、また溶融ガラスの粘度を低下させガラスを溶融しやすくする効果を有し、必須である。2%未満では前記効果が小さい。好ましくは3%以上、より好ましくは6%以上、特に好ましくは9%以上、最も好ましくは10%以上である。20%超ではガラスが不安定になる。好ましくは17%以下、より好ましくは15%以下、特に好ましくは14.5%以下、最も好ましくは14%以下である。

#### [0017]

BaOは必須ではないが、膨張係数を大きくし、また溶融ガラスの粘度を低下させガラスを溶融しやすくする効果を有し、2%まで含有してもよい。2%超ではガラスの耐候性を低下させるおそれがある。好ましくは1.8%以下である。BaOを含有する場合、0.2%以上含有することが好ましい。なお、耐候性をより向上させたい場合にはBaOを実質的に含有しないことが好ましい。

#### [0018]

MgO、CaO、SrOおよびBaOの含有量の合計は15%以上である。15%未満では、溶融ガラスの粘度が大きくなりすぎガラスの溶融が困難になる、または膨張係数が小さくなりすぎる。好ましくは15.2%以上である。

#### [0019]

ZnOは必須ではないが、膨張係数を大きくし、また溶融ガラスの粘度を低下させガラスを溶融しやすくする効果を有し、4%まで含有してもよい。好ましくは2%以下である。

#### [0020]

Li<sub>2</sub>Oは必須ではないが、膨張係数を大きくし、また溶融ガラスの粘度を低下させガラスを溶融しやすくする効果を有し、2%まで含有してもよい。2%超ではガラスの耐候性を低下させるおそれがある。好ましくは1.5%以下、より

好ましくは1%以下である。 $\text{Li}_2\text{O}$ を含有する場合、0.1%以上含有することが好ましい。

[0021]

 $Na_2$ Oは必須ではないが、膨張係数を大きくし、また溶融ガラスの粘度を低下させガラスを溶融しやすくする効果を有し、10%まで含有してもよい。10%超ではガラスの耐候性を低下させるおそれがある。好ましくは8%以下である。 $Na_2$ Oを含有する場合、2%以上含有することが好ましい。

[0022]

 $K_2$ Oは必須ではないが、膨張係数を大きくし、また溶融ガラスの粘度を低下させガラスを溶融しやすくする効果を有し、12%まで含有してもよい。12% 超ではガラスの耐候性を低下させるおそれがある。好ましくは10%以下、より好ましくは8%以下、特に好ましくは6%以下、最も好ましくは3.5%未満である。 $K_2$ Oを含有する場合、2%以上含有することが好ましい。

[0023]

BaO、Li $_2$ O、Na $_2$ OおよびK $_2$ Oの含有量の合計は14%以下であることが好ましい。14%超では耐候性が低下するおそれがある。より好ましくは13%以下、特に好ましくは12%以下である。

[0024]

 $TiO_2$ は必須ではないが、膨張係数を大きくし、ガラスの耐候性を高くし、またはガラス転移点を高くする効果を有し、10%まで含有してもよい。10%超ではガラスが不安定になるおそれがある。好ましくは9%以下である。 $TiO_2$ を含有する場合、1%以上含有することが好ましく、2%以上含有することがより好ましい。なお、分相または着色をより抑制したい場合、または液相温度をより低下させたい場合には $TiO_2$ を実質的に含有しないことが好ましい。

[0025]

 $A1_2O_3$ および $TiO_2$ の含有量の合計は11%以上である。11%未満では 耐候性が低下する。好ましくは13%以上、より好ましくは15%以上、特に好ましくは16%以上である。

[0026]

Zr $O_2$ は必須ではないが、ガラスの耐候性を高くし、またガラス転移点を高くする効果を有し、5%まで含有してもよい。5%超ではガラスが不安定になるおそれがある、または液相温度が高くなりすぎるおそれがある。好ましくは4%以下である。Zr $O_2$ を含有する場合、1%以上含有することが好ましい。

# [0027]

本発明のガラスは実質的に上記成分からなるが、この他の成分を、本発明の目的を損なわない範囲で含有してもよい。前記他の成分の含有量の合計は10%以下であることが好まして、5%以下であることがより好ましい。

たとえば、 $SO_3$ 、C1、 $As_2O_3$ 、 $Sb_2O_3$ 等の清澄剤を含有してもよい。 これら清澄剤の含有量の合計は1%以下であることが好ましい。

ガラスを着色させたい場合、 $Fe_2O_3$ 、NiO、CoO等の着色剤を含有してもよい。これら着色剤の含有量の合計は1%以下であることが好ましい。

#### [0028]

ガラスの溶解性や安定性を向上させるために、 $P_2O_5$ 、 $V_2O_5$ 等の溶解促進剤を含有してもよい。これら溶解促進剤の含有量の合計は2%以下であることが好ましい。

ヤング率を大きくしたい場合、L a  $_2$   $O_3$ 、Y  $_2$   $O_3$  等の希土類金属酸化物を含有してもよい。これら希土類金属酸化物の含有量の合計は 9 %以下であることが好ましい。

#### [0029]

本発明のガラス基板は、磁気ディスク、光ディスク等の情報記録媒体、PDP 、FED等のフラットディスプレイ、等の基板として用いられる。

本発明のガラス基板は本発明の基板用ガラスからなり、表面を充分洗浄して付着物が認められない状態にした後、120  $\mathbb C$ 、2 気圧の水蒸気雰囲気に20 時間保持したとき、該ガラス基板表面に存在する大きさが10  $\mu$  m以上の付着物の数  $N_L$ は1 個/ $\mathbf c$   $\mathbf m^2$ 以下であり、大きさが1  $\mu$  m以上10  $\mu$  m未満の付着物の数 $\mathbf N$   $\mathbf c$  は $10^5$  個/ $\mathbf c$   $\mathbf m^2$ 以下である。

# [0030]

 $N_L$ が1個 $/cm^2$ 超または $N_S$ が $10^5$ 個 $/cm^2$ 超では、ガラス基板在庫中に

ガラス基板表面に付着物(白ヤケ)が発生し、磁気ディスクにおいてはガラス基板上に形成される下地膜、磁性膜、保護膜等の膜がはがれやすくなる。また、フラットディスプレイパネルにおいてはガラス基板が曇り、また、端子取り出し部に発生した前記付着物により絶縁破壊が起こりフラットディスプレイパネルの信頼性を低下させる。この付着物は、空気中の水分や炭酸ガスの影響によりガラス基板に生成付着した反応生成物であると考えられ、拭いても除去できないものである。 $N_L$ は好ましくは0. 5個/ c  $m^2$ 以下、より好ましくは0. 2 個/ c  $m^2$ 以下である。 $N_S$ は好ましくは0.  $8\times10^5$ 個/ c  $m^2$ 以下、より好ましくは0.  $6\times10^5$ 個/ c  $m^2$ 以下である。

[0031]

本発明の基板用ガラスおよびガラス基板の製造方法は特に限定されず、各種方法を適用できる。たとえば、通常使用される各成分の原料を目標組成となるように調合し、これをガラス溶融窯で加熱溶融する。バブリング、撹拌、清澄剤の添加等によりガラスを均質化し、周知のフロート法、プレス法、またダウンドロー法などの方法により所定の厚さの板ガラスに成形し、徐冷後必要に応じて研削、研磨などの加工を行った後、所定の寸法・形状のガラス基板とされる。成形法としては、特に、大量生産に適したフロート法が好適である。

[0032]

# 【実施例】

各成分の原料を表の $SiO_2$ から $ZrO_2$ までの欄に質量百分率表示で示した組成となるように調合し、白金るつぼを用いて $1550\sim1650$  C の温度で $3\sim5$  時間溶解した。次いで溶融ガラスを流し出して板状に成形し、徐冷した。なお、表のRO計はMgO、CaO、SrOおよびBaOの含有量の合計、AlTiはAl $_2O_3$ およびTiO $_2$ の含有量の合計、BLNKはBaO、Li $_2$ O、Na $_2$ OおよびK $_2$ Oの含有量の合計である。

[0033]

こうして得られたガラス板について、膨張係数  $\alpha$  (単位: $\times$  10 $^{-7}/\mathbb{C}$ )、前 記  $N_L$  (単位:個/ c  $m^2$ )、前 記  $N_S$  (単位:1 0  $^4$  個/ c  $m^2$ )、密度  $\rho$  (単位:g / c  $m^3$ )、ガラス転移点  $T_g$  (単位: $\mathbb{C}$ )、液相温度  $T_L$  (単位: $\mathbb{C}$ )、粘

度が $10^4$ Pとなる温度 $T_4$ (単位: $\mathbb{C}$ )、および粘度が $10^2$ Pとなる温度 $T_2$ (単位: $\mathbb{C}$ )を、以下に示す方法により測定した。結果を表に示す。なお、表中の「-」は測定しなかったことを示す。

[0034]

α:示差熱膨張計を用いて、石英ガラスを参照試料として室温から5℃/分の割合で昇温した際のガラスの伸び率を、ガラスが軟化してもはや伸びが観測されなくなる温度、すなわち屈伏点まで測定し、得られた熱膨張曲線から50~350℃における平均線膨張係数を算出した。

[0035]

[0036]

ρ:アルキメデス法により測定した。

 $T_g$ : 前記  $\alpha$  の測定と同様にして得られた熱膨張曲線における屈曲点に相当する温度をガラス転移点とした。

 $T_L$ : ガラスを乳鉢で 2 m m程度のガラス粒に粉砕し、このガラス粒を白金ボートに並べて置き、温度傾斜炉中で 2 4 時間熱処理した。結晶が析出しているガラス粒の温度の最高値を液相温度とした。フロート成形を行うためには、 $T_L$ は  $T_\Delta$ 以下であることが好ましい。

 $T_4$ 、 $T_2$ :回転粘度計により測定した。

[0037]

例1~15のガラスは実施例である。例16のガラスはソーダライムシリカガラス、例17のガラスは磁気ディスクに従来使用されているアルミノシリケートガラス、例18のガラスはPDPに従来使用されているアルミノシリケートガラ

ス、例19~21のガラスは米国特許第5780371号明細書に記載されている磁気ディスク用の化学強化ガラスであり、アルミノシリケートガラスである。 例16~21のガラスはいずれも比較例である。

[0038]

【表1】

	例 1	例 2	例3	例4	例 5	例 6	例 7	例8
SiO <sub>2</sub>	51.3	52.0	55.1	53.1	52.7	54.6	52.8	43.9
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	12.6	12.6	13.3	13.0	14.4	13.2	8.3	16.5
В₂О₃	0	0	0	2.2	o <sup>*</sup>	0	3.1	0
МдО	2.6	2.8	5.2	3.2	3.2	6.0	-2.8	2.6
CaO	4.1	4.1	7.7	8.0	7.7	4.3	4.1	8.9
SrO	10.6	12.4	2.4	4.0	4.6	5.1	12.6	14.0
ВаО	0	0	0	0	0	0	0	0.5
Li <sub>2</sub> O	0	0	0	0	0	0	0	0
Na <sub>2</sub> O	4.8	4.5	5.3	4.5	4.6	4.7	4.6	2.3
K <sub>2</sub> O	6.7	6.8	5.5	6.8	7.6	7.1	6.9	2.5
TiO <sub>2</sub>	5.2	4.8	5.5	2.4	2.4	5.0	4.8	8.8
ZrO2	2.1	0	0	2.8	2.8	0	0	0
RO計	17.3	19.3	15.3	15.2	15.5	15.4	19.5	26.0
AlTi	17.8	17.4	18.8	15.4	16.8	18.2	13.1	25.3
BLNK	11.5	11.3	10.8	11.3	12.2	11.8	11.5	5.3
α	85	85	80	81	84	82	86	75
N <sub>L</sub>	0	0	0	0 -	0	0	0	0
Ns	3	3	2	1	5	2	2	1
ρ	2.74	2.73	2.63	2.64	2.66	2.64	2.70	2.89
Тя	671	659	667	660	677	667	619	710
T <sub>L</sub>	1102	1114	_					
Τ 4	1124	1114			_	_		
Т 2	1497	1499		_	_	_		

[0039]

【表2】

	例 9	例10	例11	例12	例 1_3	例14	例15
SiO2	58.5	51.5	54.2	52.1	53.1	52.8	52.8
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	6.4	16.0	12.5	13.5	13.3	13.4	13.4
В₂О₃	0	0.5	0	0	0	0	0
MgO	5.1	2.4	1.0	3.0	2.9	3.7	3.6
CaO	5.0	6.9	4.0	7.9	0	0	0
SrO	8.3	9.2	12.3	9.5	13.5	14.0	14.0
ВаО	0	0	0	0	0	0	0
Li <sub>2</sub> O	0	0	0	0	0.4	0.4	0.4
Na <sub>2</sub> O	4.7	5.0	4.5	4.6	6.3	7.0	6.3
K <sub>2</sub> O	7.0	6.2	6.8	5.7	4.1	3.2	4.0
TiO2	5.0	0	4.7	1.0	4.6	4.1	4.1
ZrO2	0	2.3	0	2.7	1.8	1.4	1.4
RO計	18.4	18.5	17.3	20.4	16.4	17.7	17.6
AlTi	11.4	16.0	17.2	14.5	17.9	17.5	17.5
BLNK	11.7	11.2	11.3	10.3	10.8	10.6	10.7
α	84	83	83	82	82	82	83
N <sub>L</sub>	0	0	0	0	О	0	0
N <sub>s</sub>	7	6	1	7	2	3	2 ·
ρ	2.66	2.69	2.70	2.72	2.73	2.74	2.74
Тя	645	660	660	672	633	628	630
T <sub>L</sub>	_	_	_		1119	1102	1102
T 4					1120	1102	1105
Т 2	<u> </u>	_	<u> </u>		1532	1497	1502

[0040]

【表3】

	例16	例17	例18	例19	例20	例21
SiO <sub>2</sub>	72.5	63.0	58.0	53.6	48.5	54.6
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.0	14.0	12.0	10.0	14.8	3.0
B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0	0	0	2.2	0	0
MgO	2.5	0	2.0	4.2	3.8	4.2
CaO	9.5	0	5.0	6.8	6.6	3.5
SrO	0	0	2.0	7.0	7.0	8.0
ВаО	0	0	6.0	2.8	5.5	3.8
Li <sub>2</sub> O	0	6.0	0	0	0	0
Na <sub>2</sub> O	14.0	10.0	4.5	5.2	5.3	6.0
K <sub>2</sub> O	0.5	0	8.5	6.2	6.5	6.9
TiO <sub>2</sub>	0	0	О	0	0	0
ZrO2	0	7.0	2.0	2.0	2.0	10.0
RO計	12.0	0	15.0	20.8	22.9	19.5
AlTi	1.0	14.0	12.0	10.0	14.8	3.0
BLNK	14.5	16.0	19.0	14.2	17.3	16.7
α	85	90	84		<u> </u>	
N <sub>L</sub>	10000	20000	0	О	0	0
N <sub>s</sub>	50	40	40	40	30	30
ρ	2.50	2.52	2.63	_		_
Тя	550	500	649	<u> </u> -	<u> </u>	

# [0041]

# 【発明の効果】

本発明によれば、以下のような特長を有する情報記録媒体用ガラス基板、フラットディスプレイ用ガラス基板を提供できる。

- (1) 化学強化処理がなくとも耐候性に優れ、在庫中に付着物(白ヤケ)が発生しにくい。
- (2) 膨張係数が従来使用されているソーダライムシリカガラスと同程度またはそれ以上である。

(3)ガラス転移点が高く、情報記録媒体の記録密度を増加させることができ、またフラットディスプレイ画像をより精細にできる。

# 【書類名】要約書

# 【要約】

【課題】化学強化処理なしでも耐候性に優れる組成の基板用ガラスの提供。

【解決手段】質量百分率表示で、 $SiO_2: 40\sim 59$ 、 $A1_2O_3: 5\sim 20$ 、  $B_2O_3: 0\sim 8$ 、 $MgO: 0\sim 10$ 、 $CaO: 0\sim 12$ 、 $SrO: 2\sim 17$ 、 $BaO: 0\sim 2$ 、 $ZnO: 0\sim 4$ 、 $Li_2O: 0\sim 2$ 、 $Na_2O: 0\sim 10$ 、 $K_2O: 0\sim 12$ 、 $TiO_2: 0\sim 10$ 、 $ZrO_2: 0\sim 5$ 、 $MgO+CaO+SrO+BaO \ge 15$ 、 $A1_2O_3+TiO_2 \ge 11$ である。

【選択図】なし

# 出願人履歴情報

識別番号

[000000044]

1. 変更年月日

1999年12月14日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都千代田区有楽町一丁目12番1号

氏 名

旭硝子株式会社